EUROPEAN PATENT OFFICE

Patent Abstracts of Japan

PUBLICATION NUMBER

63095347

PUBLICATION DATE

26-04-88

APPLICATION DATE

09-10-86

APPLICATION NUMBER

61240258

APPLICANT: NOK CORP;

INVENTOR :

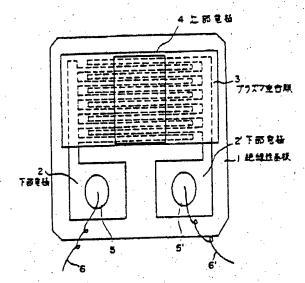
SUGIYAMA YASUSHI;

INT.CL.

G01N 27/12

TITLE

MOISTURE SENSOR



ABSTRACT :

PURPOSE: To improve resistance to water and heat and response, by covering the surfaces of conductive comb-shaped lower electrodes formed on an insulating substrate with a plasma polymer film of organic silicon compound to form an upper electrode on the plasma polymer film.

CONSTITUTION: Conductive comb-shaped lower electrodes 2 and 2' are formed on an insulating substrate 1 made of glass or the like, the surfaces thereof are covered with a plasma polymer film 3 with the thickness of about 500~20,000 in general and an upper electrode 4 is formed on the polymer film 3. That portion of drawing electrode portion not covered with the polymer film 3 is provided with leads 6 and 6' by the use of solder or silver pastes 5 and 5'. With such an arrangement, the resistance to water and heat and response can be improved.

COPYRIGHT: (C)1988,JPO&Japio

⑲ 日本 国特 許 庁 (JP)

① 特許出願公開

⑩公開特許公報(A)

昭63 - 95347

@Int; Cl.⁴

織別記号

厅内整理番号

@公開 昭和63年(1988) 4月26日

G 01 N 27/12

G-6843-2G K-6843-2G

等査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

◎発明の名称

湿度センサ

②特 顧 昭61-240258 22出 願 昭61(1986)10月9日

神奈川県茅ケ崎市赤松町1-1

砂出 願

東京都港区芝大門1丁目12番15号

弁理士 吉田 俊夫 00代 理 人

発明の名称

- 2. 特許額求の範囲
- 1. 絶像性基板上に形成させた取冠性くし型下 部電柜の表面を、有機けい素化合物プラズマ宜合 **吸で取い、はプラズマ風合腹上に上部電控を形成** せしめてなる程度センサ・
- 2. 有優けい頭化合物プラズマ重合膜がメトキ シ基またはエトキシ基を含有する有級けい薪化合 物のプラズマ型合数である特許請求の項四郎1項 記録の歴度センサ・二
- 3 発明の詳細な説明

(应禁上の利用分野)

本発明は、湿度センサに関する。更に詳しくは、 お最後出型の程度センサに関する.

(従来の技術)

従来、高分子膜を感湿膜とする湿度センサには、 抵抗校出型と容量校出型のものがある。解者は、 絶称性基板上に形成させた導電性くし型電極の表

面を高分子允殊質よりなる膜状体で被阻した構造 をとっており、この百分子感傷膜は結解水に格解 し易く、また欧μmという吸収のため根底応答性 が忍く、相対程度検出范囲(約30~90% RH)も較い という欠点を一般に有している。

また後者は、抵抗検出型の経過でのくし型電極 を下部は極とし、更に高分子感起酸の上に上部電 極を形成させ、これによって四分子膜を上、下阿 電板で挟んだ構造をとっており、抵抗検出型のも のと比較して、耐水性や相対湿度検出。短頭(0-100 % RH)の点では良いものの、やはり高分子 豚の厚 膜のため広答性が数分程度と応く、また膜の耐熱 性も一段に50℃程度と低いため、温度センサとし ての使用に限界がみられる。

【 発明が解決しようとする問題点 】

本務明者は容量校出型組度センサにみられるこ うした欠点を保消させ、特に応答性の点ですぐれ た短度センサを得るべく種々検討を重ねた結果。 上、下面配荷間に数包される路分子感復しを存役 けい新化合物のプラズマ配合設で形成させること

により、かかる無題が効果的に解決されることを 引出した。

【 問題点を解決するための手段 〕および[作用)

従って、本発明は容量検出型の機度センサに係り、この温度センサは、絶象性基板上に形成させた準理性くし型下部電極の表面を、有機けい素化合物のプラズマ重合膜で覆い、 彼プラズマ重合膜上に上部電極を形成せしめてなる。

容量検出型の程度センサは、抵抗検出型のものが感視酸を形成している電解質が限度によって解離イオン量を変化させ、それによって湿度センサの抵抗を変化させるという原理に基いているのに対し、感限膜が非電解質から形成され、湿度によって一定の誘性中を有する水分子の感想酸中での濃度が変化し、それによって容量が変化するという原理に基いている。

本発明においては、かかる感傷酸として有機けい 別化合物、 好ましくはビニルトリメトキシシラン、 ビニルメチルジエトキシシラン、 メチルジエトキシ 法 ナトキシ 芸

を含有する有機けい素化合物のプラズマ重合膜が 用いられる。有機けい素化合物のプラズマ重合膜 は、絶縁性基板との接着性にすぐれ、特にアルコ キシ基を含有する有機けい素化合物は重合膜の堆 被速度が大きく、また膜中に S1-0-S1 結合を形 成させるため強固な膜を形成させる。

図面の第1回は、本発明に係る容量検出型の提及センサの一度様を示すそれの平面圏であり、絶象性基板1上に専電性くし型電板2、2、が形成され、その表面は一般に約500人~20000人(2μm)程度の膜厚を有する上記プラズマ重合膜3によって変われており、このプラズマ重合膜の上には上節電極4が形成されている。

このように構成される温度センサの容量検出は、下部電極2、2'間の距離が長く、そのままでは上部電極の容量が小さいため、中間電極として作用し、結局下部電極2、2'間に容積される容量として検出される。従って、この程度センサの等価回路は、次の如くとなる。



なお、この2、2'の符号によって投示される、ブラズマ重合膜によって使われていない取出電極部分には、半田付けあるいは銀ペースト5、5'により、リード誌6、6'が取り付けられている。

絶象性基板としては、一般にガラス、石英、アルミナ、セラミックスなどが用いられるが、感湿素子への温度追旋性が更に良好なことが望まれる場合などには、やはり本出原人よって提案されているシリコン基板表面を酸化して形成させた絶象膜(特級昭60~122,548号)なども用いることができる。

これらの絶縁性基板上へ下部電極として導電性 くし型電極を形成させるに際しては、まず絶縁性 基板上に、ステンレススチール、ハステロイC、 インコネル、モネル、金などの耐食性金属や銀、 アルミニウムなどの電極形成材料金属をスパッタ リング法、イオンプレーティング法などにより、 約0.1~0.5 д m 程度の厚さの存取を形成させ、次に そこにフォトレジストパターンを形成させる。

あるいは、基板上に南刺可格性樹脂のフォトレジストパターンを形成させた後、腹灰クロムおよび金を蒸着させ、フォトレジストを培剤で溶解除去する方法、基板上に金ペーストを用いてスクリーン印刷法を適用する方法などによっても厚電性くし型電極の形成を行なうことができる。

特開昭63-95347 (3)

このようにして絶縁性基板上に形成させた現代性くし型下部電極の表面は、可機けい消化合物のプラズマ取合膜で関われる。プラズマ取合は、真空プラズマ重合製門内に可機けい消化合物を散ミリー数Torrの圧力になる迄導入し、そこに数一数10Wの放電出力の近周被電力を供給することにより行なわれる。

その後、プラズマ瓜合の場合と同様に必要なマスキングを施し、蒸芥製四内で金、白金などを約200~400人の駆斥で蒸着させ、上部電情を形成さ

(発明の効果)

本発明に係る程度センサは、容量検出型のため そもそも相対程度検出範囲が広いばかりではなく、 認程膜として有機けい素化合物、特に高架橋化さ れるメトキシ抜またはエトキシ抜を含有する有機 けい素化合物のプラズマ型合膜が用いられている ため、耐水性、耐熱性が改善され、また応答性の 点でもすぐれている。

(夹施例)

容量がほぼ直線的に変化することが分かる。

また、この温度センサを150℃に加熱する耐熱 試験を行なうと、第3回のグラフに示されるよう な結果が得られた。

4. 図面の簡単な説明・

第1回は、本発明に係る程度センサの一定様の 平面図である。第2回は、この程度センサを用い た場合の相対程度に対する節電容量の関係を示す グラフである。また、第3回は、この程度センサ の耐熱試験の結果を示すグラフである。

(符号の説明)

: 1・・・・・ 絶縁性基板

2.2 *** 下部電極.

3・・・・プラズマ盤合版

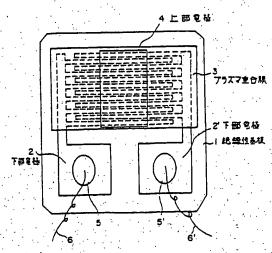
4・・・・上部電便

次に、突旋例について本発明を説明する。 本体例

ガラス拡板上にフォトレジストによりくし型電 係と反対のパターンを形成させた後、蒸着法によりクロムを500人の腹頂で、次いで金を1000人の 膜厚で蒸着させた後、フォトレジストを溶解させ て、運転性くし型電極を形成させた。

このようにして形成された容量検出型の温度センサについて、相対程度に対する静電容量を測定すると、第2回のグラフに示されるような結果が切られた。この結果から、相対温度に対して静電

第 1 図



· 代理人

办理士 古田 俊 夫

